



SUOMI-FINLAND
(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

(11) (21) Patenttihakemus - Patentansökan	952995
(51) Kv.1k.6 - Int.cl.6	
C 07F 1/00 // C 23C 16/40	
(22) Hakemispäivä - Ansökningsdag	16.06.95
(24) Alkuperä - Löpdatum	16.06.95
(41) Tullut julkiseksi - Blivit offentlig	18.12.95
(32) (33) (31) Etuoikeus - Prioritet	
17.06.94 US 261572 P	

(71) Hakija - Sökande

1. Hewlett-Packard Company, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, USA, (US)

(72) Keksijä - Uppfinnare

1. DiCarolís, Stephen, 2212 Cabrillo avenue, Santa Clara, CA 94304, USA, (US)

(74) Asiamies - Ombud: Oy Kolster Ab

(54) Keksinnön nimitys - Uppfinningens benämning

Esiasteiden stabilointi ohutkalvojen saostamista varten
Sabilisering av prekursorer för utfällning av tunnfilmer

(57) Tiivistelmä - Sammandrag

Keksintö koskee sellaisen esiasteen stabilointia, jota käytetään MOCVD-reaktorissa tietyistä metallioksidoista koostuvien ohutkalvojen valmistamiseksi, tuomalla esiasteeseen ligandi esiasteen synteesin aikana ja suojaamalla esiaste siten ennenaikaiselta hapettumiselta, ydintymiseltä ja hajoamiselta. Keksintö koskee myös mainittua esiastetta. Esiaste koostuu additiotuotteesta, jolla on kaava M-E-T, jossa M on alkalimetalli-, kupari-, nikkeli-, koboltti-, mangaani- tai sinkkikationi, E on kruunueetteri ja T on diketonianioni.

Uppfinningen avser stabilisering av ett sådant förstadium, som användes i en MOCVD-reaktor för framställning av filmer bestående av vissa metalloxider, genom att införa en ligand i förstadiet under syntesen och sålunda skydda förstadiet gentemot för tidig oxidation, nukleation och sönderfall. Förstadiet består av en additionsprodukt med formeln M-E-T, vari M är en alkalimetall-, koppar-, nickel-, kobolt-, mangan- eller zinkkation, E är en kruunueetter och T är en diketonanjon.